

Wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in für Technologie InP-HBT-Höchstfrequenzschaltungen

Zur Verstärkung unseres InP-Devices Lab suchen wir eine/einen wissenschaftlichen Mitarbeiter/-in für die Technologie zur Realisierung von Höchstfrequenz-InP-HBT-Schaltungen

(Kennziffer 14/18)

Das InP Devices Lab bündelt die Arbeiten zur Technologie und der Bauelemententwicklung von InP-basierten Halbleitern. Als FBH betreiben wir in einer industrie-kompatiblen Reinraum-Umgebung einen InP-HBT Transfersubstrat-Prozess für den Frequenzbereich über 100 GHz. Derzeit erreichen wir Transitfrequenzen von 530 GHz und haben integrierte Schaltungen bis 330 GHz realisiert. Basierend darauf wurde gemeinsam mit dem Leibniz-Institut IHP ein InP-auf-BiCMOS-Prozess entwickelt, der auch für externe Partner zur Verfügung steht.

Ihre Aufgaben beinhalten die

- Weiterentwicklung von Prozessmodulen der InP-Schaltungstechnologie sowie deren Überführung auf neue Anlagen. Im Rahmen der BMBF-geförderten Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland erneuert das FBH derzeit seinen Anlagenpark. Dabei wird eine weitere Erhöhung von Transistor-Grenzfrequenz, Zuverlässigkeit, Lebensdauer und Ausbeute angestrebt.
- Bearbeitung und Qualitätssicherung von Waferlosen mit MMICs für interne und externe Projekte
- Dokumentation, Veröffentlichung und Präsentation der Forschungsergebnisse

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium (Master, Diplom) in den Bereichen Physik, Elektrotechnik, Mikrosystemtechnik oder verwandten Fachrichtungen. Umfangreiche Kenntnisse in der Technologie von elektronischen III-V-Halbleiterbauelementen sowie praktische Erfahrung bei der Halbleiterprozessierung sind wünschenswert. Dabei kommen sowohl Promovierte als auch Doktorandinnen/Doktoranden in Frage.

Wir suchen eine/einen Teamplayer/-in mit einem hohen Maß an Kommunikationsfähigkeit und Zuverlässigkeit für die Arbeit in einem multidisziplinären Team. Ein sicherer Umgang mit der englischen Sprache wird vorausgesetzt, ebenso die Eignung für die Arbeit im Reinraum.

Die Stelle kann baldmöglichst besetzt werden. Sie ist zunächst auf 2 Jahre befristet. Die Vergütung erfolgt nach TVöD (Bund). Bei Interesse wird die Möglichkeit zur Anfertigung einer Promotion aktiv unterstützt.

Für weibliche und männliche Bewerber besteht Chancengleichheit. Qualifizierte Frauen werden daher besonders aufgefordert, sich zu bewerben. Schwerbehinderte erhalten bei gleicher Qualifizierung den Vorzug.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung. Dazu klicken Sie bitte auf „[Online bewerben](#)“ und übermitteln uns auf diesem Wege Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis **zum 30.06.2018**.

Falls Sie noch Fragen zur Bewerbung haben, wenden Sie sich bitte an Frau Nadine Möller:

Tel. 030 6392 2691

nadine.moeller@fbh-berlin.de

Profil

Das Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH) im Forschungsverbund Berlin e. V. ist ein international führendes Forschungsinstitut auf den Gebieten der Diodenlaser, UV-LEDs und der Mikrowellenbauelemente.

Auf der Basis von III/V Halbleitern erforscht und realisiert es Komponenten und Systeme u.a. für Anwendungen in Kommunikation, Verkehrs- und Produktionstechnik, Medizin und Biotechnologie. Es verfügt über die gesamte Wertschöpfungskette vom Design bis zu lieferfertigen Systemen.

Weiteres unter: www.fbh-berlin.de